

Rohm[®]
QUALITY · RELIABILITY



2SA934

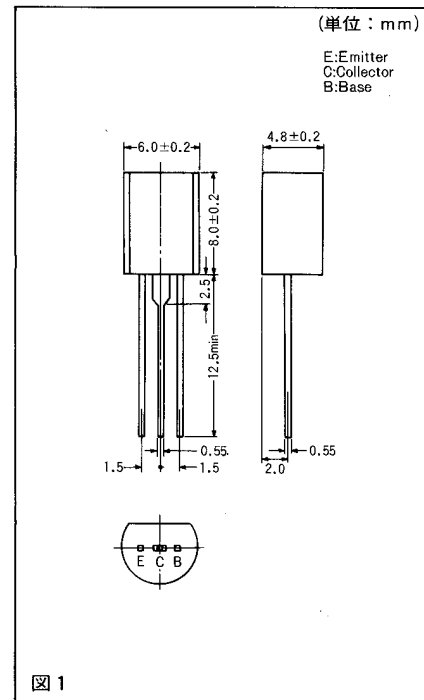
トランジスタ

PNP
type

PNP エピタキシャルプレーナ型
シリコントランジスタ

1~2W低周波出力用

■ 外形寸法図 (Physical Dimension)



■ 絶対最大定格 (Ta=25°C) (Absolute Maximum Ratings)

項目	記号	定格	単位
コレクタベース電圧	V _{CB0}	-40	V
コレクタエミッタ電圧	V _{CEO}	-32	V
エミッタベース電圧	V _{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I _c	-1 -2*	A dc. A pulse.
コレクタ損失	P _c	750	mW
ジャンクション温度	T _j	125	°C
保存温度	T _{stg}	-55~125	°C

* P_w = 20m sec, duty = 1/2

■ 電気的特性 (Ta=25°C) (Electrical Characteristics)

項目	記号	MIN	TYP	MAX	単位	条件
コレクタエミッタ降伏電圧	BV _{CEO}	-32	—	—	V	I _c = -1mA
コレクタベース降伏電圧	BV _{CB0}	-40	—	—	V	I _c = -50μA
エミッタベース降伏電圧	BV _{EBO}	-5	—	—	V	I _E = -50μA
コレクタシャ断電流	I _{CB0}	—	—	-0.5	μA	V _{CB} = -20V
エミッタシャ断電流	I _{EBO}	—	—	-0.5	μA	V _{EB} = -4V
コレクタエミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	—	—	-0.5	V	I _c /I _B = -500mA/-50mA
直流電流増幅率	h _{FE}	82	—	390	—	V _{CE} /I _c = -3V/-100mA
利得帯域幅積	f _T	50	150	—	MHz	V _{CE} = -5V, I _E = 50mA
出力容量	C _{ob}	—	20	30	pF	V _{CB} = -10V, I _E = 0, f = 1MHz

h_{FE} の値により下表のように分類します。

アイテム	P	Q	R
h _{FE}	82~180	120~270	180~390

2SA934